



27 сентября 2012 года исполняется 80 лет со дня рождения старшего научного сотрудника лаборатории инфракрасной оптоэлектроники кандидата физико-математических наук Зотовой Нонны Вячеславовны.

Окончив в 1955 году Ленинградский Государственный Университет, Нонна Вячеславовна начала свою трудовую деятельность в лаборатории электронных полупроводников ФТИ им. А.Ф. Иоффе, посвятив её исследованию узкозонных полупроводниковых соединений АЗВ5, синтез которых в это время активно осваивался в ФТИ.

Одним из итогов этой работы явилось создание датчиков Холла для измерения больших постоянных токов (~ 100 кА), которые были отмечены малой золотой медалью ВДНХ. Последующие работы, связанные с изучением p-n структур и рекомбинационных процессов в арсениде индия и его твердых растворов, привели к созданию первых низкопороговых инжекционных лазеров и неохлаждаемых светодиодов в средней ИК-области спектра (3-5 мкм). В последнее время научные интересы Нонны Вячеславовны были связаны с изучением фотонных кристаллов и отрицательной люминесценции в p-n структурах.

Зотова Н.В. является высококвалифицированным специалистом, широко известным в нашей стране и за рубежом. Она является автором более 150 научных работ и 10 изобретений и патентов, активно участвовала в развитии международных научных контактов и уделяла много внимания работе с молодыми учеными. Под её руководством защищено более 10 кандидатских диссертаций. За достигнутые успехи в научной работе неоднократно премировалась Президиумом РАН, а такие работы с её участием, как «Полупроводниковый метанометр» и «Диодные оптопары положительного и отрицательного контраста» отмечены среди основных достижений ФТИ им. А.Ф. Иоффе.

